查询2SC1652供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

T-27-09

2SC1652 2SC4037

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ 中電力増幅用/Medium Power Amp. Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors

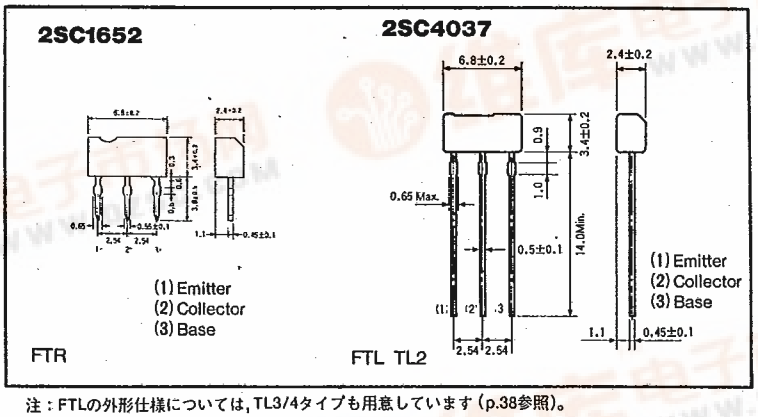
● 特長

1) $I_{C\,MAX}$= 500mAと大きい。
2) $V_{CE(sat)}$が低く低電圧動作に適している。
3) 2SA874/2SA1559とコンプリ。

● Features

1) Large collector current: I_C=500mA
2) Low collector saturation voltage, enabling low-voltage operations.
3) Complementary pair with 2SA874, 2SA1559.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



注：FTLの外形仕様については，TL3/4タイプも用意しています（p.38参照）。

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	32	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	500	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合部温度	Tj	125	℃
保存温度範囲	Tstg	−55～125	℃

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	32	—	—	V	I_C=1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	40	—	—	V	I_C=100μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E=100μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	1	μA	V_{CB}=20V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	1	μA	V_{EB}=4V
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	V_{CE}/I_C=3V/100mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.6	V	I_C/I_B=500mA/50mA
利得帯域幅積	f_T	—	250	—	MHz	V_{CE}=5V, I_E=−20mA
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	6.2	—	pF	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82～180	120～270	180～390

● 標準品・準標準品一覧表 （◎：標準品 ○：準標準品）

Type	h_{FE}	包装名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記　号		C1	TL2	TL3
		基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SC1652	PQR		◎	○	—	—
2SC4037	PQR		—	—	○	○

トランジスタ 2SCタイプ

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

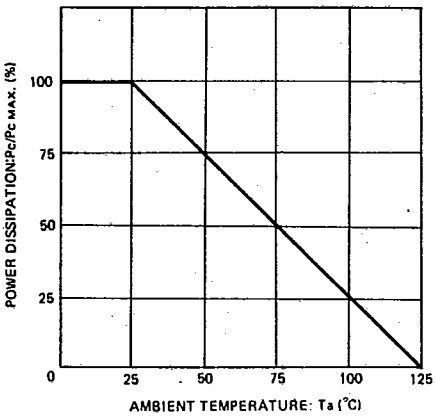


Fig.1 電力軽減曲線

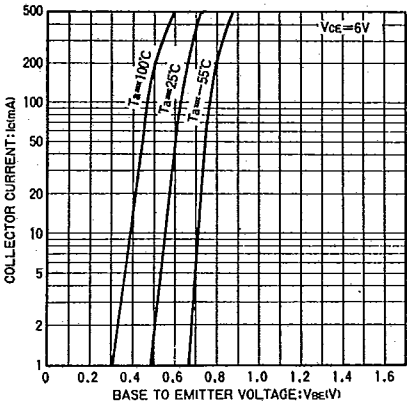


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

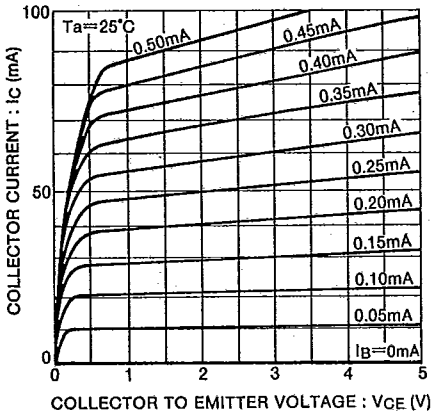


Fig.3 エミッタ接地出力静特性（I）

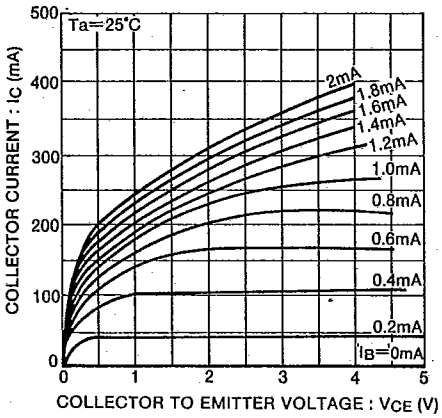


Fig.4 エミッタ接地出力静特性（II）

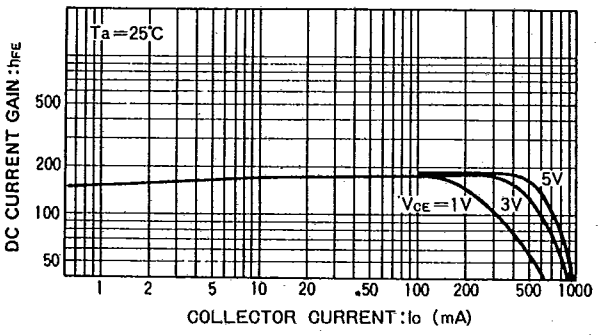


Fig.5 直流電流増幅率ーコレクタ電流特性（I）

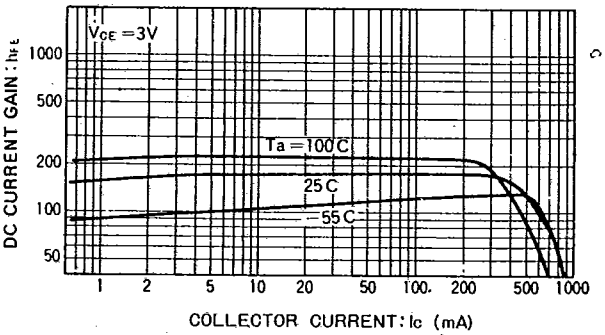


Fig.6 直流電流増幅率ーコレクタ電流特性（II）

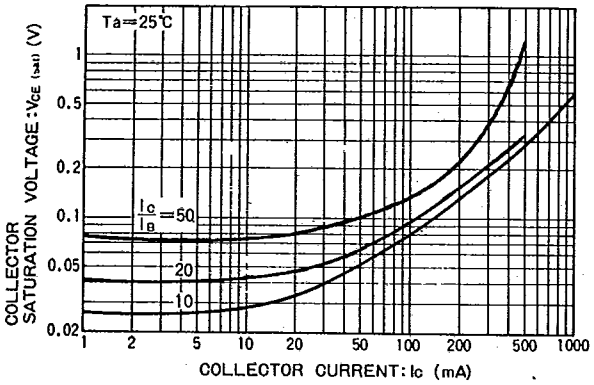


Fig.7 コレクタ・エミッタ飽和電圧ーコレクタ電流特性（Ⅰ）

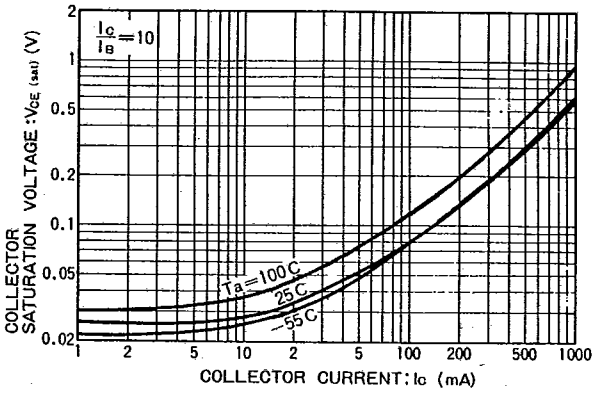


Fig.8 コレクタ・エミッタ飽和電圧ーコレクタ電流特性（Ⅱ）

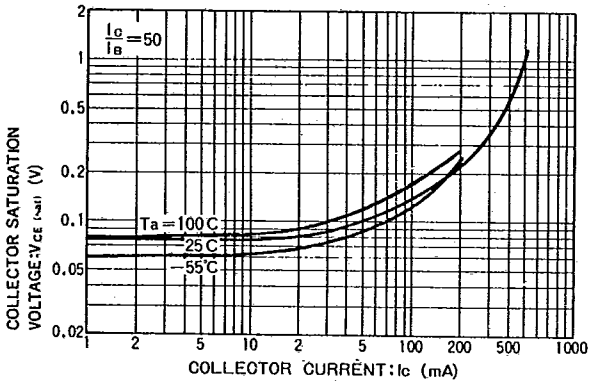


Fig.9 コレクタ・エミッタ飽和電圧ーコレクタ電流特性（Ⅲ）

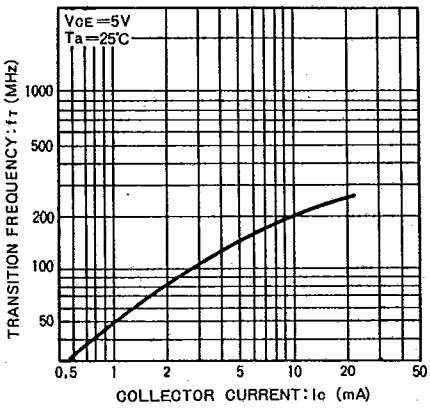


Fig.10 利得帯域幅積ーコレクタ電流特性

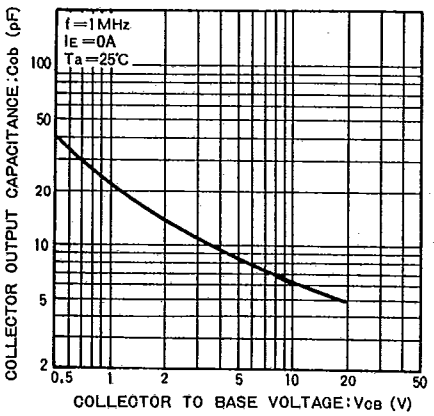


Fig.11 コレクタ出力容量ーコレクタ・ベース電圧特性

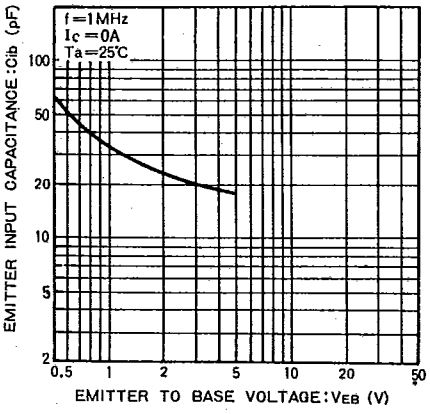


Fig.12 エミッタ入力容量ーエミッタ・ベース電圧特性

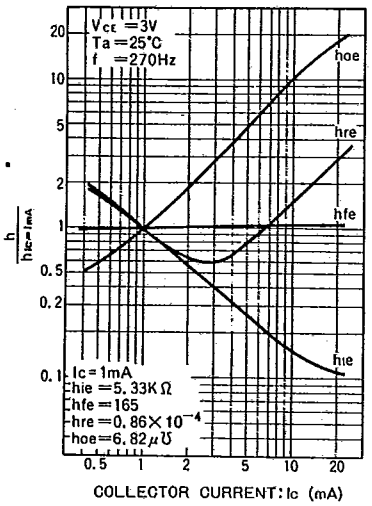


Fig.13 h定数—コレクタ電流特性

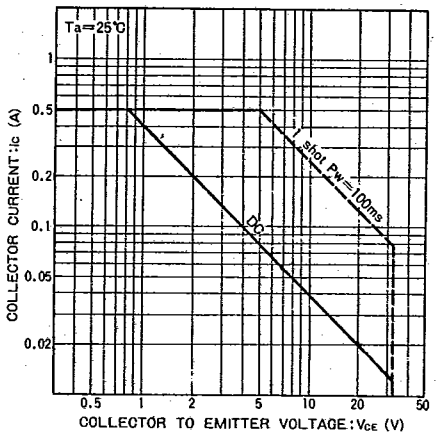


Fig.14 安全動作領域